

圖 2-1: CNT 場效發射體之製備 (a)在 Nb/Si 基板上製備 AAO 模版; (b)電化學沈積 Co(c)以 C2H2 成長 CNTs;(d)場效電晶體的製備圖[11]



圖 2-2:FE 電場對電流密度作圖(AL:A1/Si ALNB: A1/Nb/Si)[11]



圖 2-3: 多孔氧化鋁模版置備柱狀型規則奈米結構之電容流程圖[15]



圖 2-4: 模擬奈米電容之阻抗 R; R2: 各種其他的阻抗; R1: 分流器 的阻抗[15]



圖 2-6:利用 sol-gel 的方式將 TiO2 加熱到 673K、2hr 深入塗佈到 AAO 模版: (a) 10% H3PO4, 150V, 277K, tdip= 20min;(b)3%草酸 40V,

15.0kV

O/Glass

3. 8kV X28. 8K' 1. 50 mm

 Al_2O_3

293K, 5dip= 10min[12]



圖 2-8: (左)模擬的 AAO 3-D 立體圖; (右) AAO 剖面圖, 包含了胞壁、

孔洞的尺寸和長度[20][78]

Electrolyte	Temperature	Voltage	Pore diameter
1.2 M Sulfuric	1 °C	19 V	15 nm
0.3 M Sulfuric	1 °C	26 V	20 nm
0.3 M Oxalic	14 °C	40 V	40 nm
0.3 M Oxalic	14 °C	60 V	60 nm
1.0 M Phosphoric	3 °C	95 V	90 nm



表 2-1: 陽極氧化鋁的成長條件一覽表[94]

圖 2-9: TEM 下 CdS 的奈米線,直徑約 20nm;右上圖為擇區繞射[25]



圖 2-10: Bi 奈米線在 TEM 之下, (a)單一的 Bi 線(b)平行排列的 Bi

線(c)一束糾結的 Bi 線[27]



圖 2-11: 利用 AAO 製備 AgI 奈米線之設計圖[29]



圖 2-12:(a)AA0 模版(b)去除 AA0 模版後,Ag 奈米線(c)AgI/AA0 之
剖面圖(d)去除 AA0 模版後,AgI 奈米線[29]
1996
パリヤー馬
Barrier layer
アルミニウム
Aluminum
(A) バリヤー塑皮膜
(A) バリヤー塑皮膜
(A) バリヤー塑皮膜
(A) バリヤー塑皮膜
(A) バリヤー塑皮膜
(A) バリヤー塑皮膜
(B) 多孔質型皮膜
(B) Porous-type oxide film

圖 2-13:阻障層和多孔質層示意圖[116]



圖 2-14: 陽極處理時間和陽極氧化鋁膜厚的關係圖 (I:法拉第理論膜厚 II:草酸的膜厚 III:硫酸的膜厚 IV: Special case)[116]



圖 2-15:在一開始陽極處理的過程中,阻障層到多孔薄膜的 變化情形[116]

電解浴 (Anodizing bath)		ペリマー層杯さ (Thickness of barrier layer)
15% 華隆裕 (Sulfuric acid bath)	(10°C)	10.0 Å/V
2.%シュウ酸将 (Oxalic acid bath)	(24°C)	11.8 J/V
4%リン酸 (Phosphoric acid bath)	(24°C)	11.9 J /V
3%クロム議 (Chromic acid bath)	(38°C)	12.5 k /V

表 2-2:各種氧化薄膜的阻障層厚度[116]



電源条件 (Anodizing condition	孔数 (× 10%ml) (Number of pores)	
15% 職 骼	15 V	76
(Sulfuric acid bath)	20 V	52
10 °C	30 V	28
2 %シュウ酸浴	20 V	35
(Oxalic acid beth)	40 V (11
25 °C	60 V	6
3%クロム腱浴	20 V	22
(Chromic acid bath)	40 V	8
50 °C	60 V	4
4%リン陸谷	20 V	19
(Phosphoric acid bath)	40 V	8
25 °C	60 V	4

表 2-3:各種條件下陽極氧化鋁的孔洞數[116]



圖 2-17: 鋁在陽極處理的變化情形